

カスタムPtfеウェーハキャリア フラワーバスケット 耐薬品性 半導体洗浄用ハンドル設計

商品番号: PL-CP166



前書き

カスタムPTFEウェーハキャリアとフラワーバスケットで半導体歩留まりを最大化。フッ酸や過酷な試薬に対する優れた耐性を備え、人間工学に基づいたハンドルと精密CNC加工スロットを特徴とする高純度ハンドリングシステムにより、安全で汚染のないウェットプロセス洗浄を実現します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主な利点
RCA洗浄プロセス	SC-1およびSC-2溶液を用いた有機残留物と金属汚染物質の除去のための連続洗浄。	高pHおよび酸化ストレスに耐え、浴中に不純物を溶出しません。
フッ酸エッチング	濃縮HFを用いたシリコンウェーハからの自然酸化膜層または犠牲ガラス層の除去。	ガラスを溶解したり標準プラスチックを劣化させたりするHFに対して完全な耐性があります。
バイラニアエッチング/ストリッピング	硫酸と過酸化水素の混合物を用いた重有機汚染またはフォトレジストの除去。	バイラニア溶液によって発生する高い発熱温度でも構造的完全性を維持します。
フォトリソグラフィ現像	UV露光後の回路パターンを定義するための現像液へのウェーハの浸漬。	精密スロット加工により、ウェーハ表面への現像液の均一な暴露を確保します。
CMP後すすぎ	スラリー粒子を除去するための化学機械研磨（CMP）後の高純度すすぎ。	非粘性表面によりスラリーの蓄積を防止し、迅速かつ完全な汚染除去を容易にします。
化合物半導体製造	高周波エレクトロニクスおよびLED製造のためのGaAs、InP、またはSiCウェーハの処理。	優しいハンドリング特性により、より脆い化合物材料の破損を防止します。
超音波/メガソニック洗浄	サブミクロン粒子を除去するための高周波音響洗浄中のウェーハの支持。	音響キャビテーション力下での優れた振動減衰と化学的安定性。

仕様カテゴリ	PL-CP166のパラメータ詳細	カスタマイズオプション
主要材料	高純度バージンPTFE（ポリテトラフルオロエチレン）	透明性/純度向上のためのオプションPFA
ウェーハサイズ互換性	4インチ（100mm）、6インチ（150mm）、8インチ（200mm）	カスタム直径および非標準形状対応可能
スロット構成	精密切断V溝またはU溝プロファイル	カスタムスロットピッチ、深さ、角度間隔
収容能力	標準25枚または50枚構成	単一ウェーハから高容量までの特注バッチサイズ
ハンドル設計	統合トップマウントまたはサイドマウント提手	取り外し可能、延長、または自動化対応ハンドル
耐薬品性	全スペクトル（酸、塩基、溶剤、酸化剤）	HF、H2SO4、HNO3、HCl、NH4OH等に対して検証済み
使用温度	-200°C ~ +260°C	特定の熱サイクルプロファイルに合わせて調整可能
製造方法	エンドツーエンドカスタムCNC加工	自動化インターフェースのための精密公差管理

仕様カテゴリ	PL-CP166のパラメータ詳細	カスタマイズオプション
洗浄プロトコル	クリーンルーム洗浄および真空シール	微量分析のための特殊前洗浄